科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 26 年 6月 9日現在

機関番号: 12601	
研究種目:基盤研究(B)	
研究期間: 2011 ~ 2013	
課題番号: 2 3 3 6 0 0 9 2	
研究課題名(和文)ナノ細孔内部の分子・イオンの移動現象の解析と制御	
研究課題名(英文)Analysis and control of molecule and ion transport in nanopores	
研究代表者	
大宮司 啓文(Daiguji, Hirofumi)	
去去上兴,于兴(五)项内创(河内 内)。	
東京大学・上学(糸)研究科(研究院)・教授	
研究者番号:10302754	
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 14,600,000円、(間接経費) 4,380,000円	

研究成果の概要(和文):近年のナノスケールの流体システムに関する材料合成,実験計測,理論解析技術の進歩は10 ナノメートルより小さい流路内部のイオン移動を体系的に研究することを可能にしている.このように小さな系では, 大きな系では見られないような特異なイオン移動現象が見られる.10ナノメートよりも小さい流路におけるイオン移動 の研究は,細胞におけるタンパク質のイオンチャネルを模倣するような人工イオンチャネルを探索したり,高エネルギ ー密度の燃料電池におけるプロトン交換膜を探索したりする機会を提供する.この研究では,規則的な細孔構造をもつ メソポーラスシリカ内部を流れるイオン流について実験計測と理論解析を行った.

研究成果の概要(英文): Recent advances in synthesis, measurement, and analysis techniques of nanofluidic systems have allowed ion transport to be systematically explored in narrow, confined channels with dimensi ons of less than 10 nm. In such small dimensions, anomalous ion transport can be observed. The studies of ion transport in sub-10 nm fluidic channels provide opportunities to explore artificial ion channels that can mimic protein ion channels in physiological cells or proton exchange membranes in high energy density fuel cells. In this study, the measurement and analysis of ion transport in well-dimensioned mesoporous si lica by applying electric fields were conducted in order to effectively apply them to various technologies

研究分野:工学

科研費の分科・細目:機械工学・熱工学

キーワード: マイクロ・ナノスケール物質移動 流体 化学物理 化学工学

1.研究開始当初の背景

はじめに,本研究の学術的なテーマであ るナノ細孔内部の物質移動(ナノフルイデ ィクス)の背景を説明する.ナノフルイデ ィクスの研究は2000年頃から急速に増えて いる.ナノスケールの空間内の分子・イオ ンの移動については,それ以前から,物理, 化学,工学など様々な分野において研究さ れているが,最近,特に注目されている理 由として以下の3項目を挙げることができ る.

(1) 構造や組成が明確に特定できるナノス ケールの細孔をもつ材料の合成技術が進歩 したこと

(2) 観察や計測技術が進歩したこと

(3) 一分子計測などの応用技術が注目されていること

研究代表者は2002年頃,この分野の研究に 着手し、これまでにナノスケールの空間に 閉じ込められた液体の性質を利用した様々 なデバイスの提案を行ってきた.ナノフル イディク電界効果トランジスタ(Nano Lett. 4 (2004) 137),ナノフルイディク電池(N ano Lett. 4 (2004) 2315), ナノフルイデ ィクダイオード(Nano Lett. 5 (2005) 227 4, Nano Lett. 7 (2007) 547) などが挙げ られる.また,分子シミュレーションによ る理論解析も行ってきた.これらの成果は 主に次の2つの文献にまとめられている.H. Daiguji, "lon transport in nanofluidi c channels, " Chem. Soc. Rev. 39 (2010) 901; H. Daiguji, "Nanofluidics," Com prehensive Nanoscience and Technology. Academic Press (2010).これらの研究は, はじめ,生体分子の分離検出デバイスを目 指したものであったが、ナノスケールの細 孔内のイオン,分子,液体の構造的性質, 移動特性について多くの知見を得ることが できた.同時に,これらの研究をさらに発 展させれば,グリーン・イノベーションの コア技術である,吸着材,フィルタなどの 材料の高性能化・高機能化に繋がるのでは ないかという本研究課題の着想に至った.

また,本研究で対象とするナノ細孔は代 表長さが数ナノメートル,すなわち,吸 材やフィルタとして用いられている材料の 細孔と同じオーダーである.従来のナノフ クロから数10ナノメートルであり,主にサブマイ クロから数10ナノメートルであり,主にサブマイ クロから数現象の研析が可能であるのよう によっ、本研究では、分子の離散性,すな して、新たな利御友を引したの し、新たな利御友を見体的な し、新たなが泉を具体的な グリーン・イノ まつション技術へ応用することができると 考えた. 2.研究の目的

吸着材、フィルタ、触媒層、電極など、 ナノ細孔を有する材料の高性能化・高機能 化は、グリーン・イノベーションのコア技 術の一つと考えられる.ナノ細孔内部の物 質移動が正確に理解できれば,物質移動の 視点から細孔構造や表面特性を最適化する ことが可能になり,ナノ細孔を有する材料 の新たな設計指針の提案が期待される、本 研究では,特に,メソポーラスシリカのよ うな細孔構造や表面特性が比較的明らかな 親水性ナノ細孔内部のイオンの移動現象を, 理論解析,およびマイクロチップ上に合成 されたナノ細孔膜を用いた実験計測により 明らかにすることを目的とする.また,ナ ノ細孔内部のイオンの移動を正確に制御す ることに挑戦し,ナノ細孔の新たな応用可 能性を示すことを目的とする.

3.研究の方法

メソポーラスシリカのような細孔構造や 表面特性が比較的明らかな親水性ナノ細孔 内部のイオンの移動現象を明らかにし,新し い移動制御の方法を提案するために,以下の 3項目の研究を行う.

(1) メソポーラスシリカ薄膜の合成,および 移動現象を計測できるマイクロチップの製作(材料合成)

(2) イオン移動現象の実験計測 (実験計測)(3) ナノ細孔内のイオンの分布,イオンの移動現象の解析 (理論解析)

4.研究成果

(1) メソポーラスシリカ薄膜の合成,および移動現象を計測できるマイクロチップの 製作(材料合成)

ここでは2種類のメソポーラスシリカ薄膜, SA-16とSBA-15を合成し,マイクロチップを 製作した.

(a) SBA-16薄膜 初めにSi基板を,n-ヘキ サン,アセトン,純水で10分ずつ超音波洗 浄し, piranha 溶液 (H2S04: H202 = 2:1) に浸した後,超純水で洗浄してから2-プロパ ノールに1 時間浸した .次に ,TEOS (2.0 g) , エタノール (11.28 g), 純水(1.40 g), 1 M 塩酸 (0.20 g) の混合溶液を60°Cで30分, Pluronic F127(0.35 g)とエタノール(11.28 g)の混合溶液を室温で30分攪拌した.その後, 2つの溶液を混合し,室温でさらに30分攪拌 した.洗浄したSi基板を浸し,0.7 mm/sの-定速度で引き上げる.その後,基板を70°C で8 時間乾燥させる.乾燥後,440 °Cで4 時 間焼成した.ディップコーティングの工程は, 温度(25 °C)と湿度(60% RH)が調整されたグ ローブボックス内で行った.構造解析は

FE-SEM (S-4800, Hitachi High Technologies), TEM (H-9000UHR, Hitachi High Technologies), XRR & XRD system (SmartLab 9 kW system, RIGAKU)を用いて 薄膜の構造評価を行った.

図1(a)はシリコン基板上に合成されたSB A-16薄膜の上面のFE-SEM画像,図1(b)は断 面のTEM画像を示している.上面と断面の両 方において細孔が一様に分布しているのが 確認できる.これは、3D-cubic構造に見られ る特徴と一致する.また,その細孔直径10 n m程度であり,膜厚は35 nm程度である.図1 (c)はイオン電流を計測する装置の概略図を 示す.メソポーラスシリカ薄膜の上にPDMSで 作成した2つの溶液溜めを配置した.



図1 SBA-16薄膜の(a) FE-SEM画像(表面図), (b) TEM画像(断面図),(c) イオン電流計 測用マイクロチップの概略図.

(b) SBA-15薄膜 エタノール(15.0 g), 純 水(0.78 g), 0.1 M 塩酸(0.15 g)の混合溶 液,およびPluronic P123 (0.3 g)とエタノ ール(14.25 g)の混合溶液をそれぞれ別々の 容器に入れて室温で1 時間攪拌した.その後, 2つの溶液を混合して,室温でさらに1 時間 攪拌した.Si基板をこの溶液に浸した後,3.0 mm/sの引き上げ速度でディップコーティン グを行い,基板表面に薄く溶液をコーティン グした.ディップコーティングにより得られ た薄膜を,24 時間室温でエイジングし,70°C で1 時間乾燥させた後,500°C で5 時間焼 成することによりテンプレートを除去して SBA-15 薄膜を得た.

また,ここでは,マイクロスケールで規則 性の高い細孔構造をもつメソポーラスシリ カ薄膜を合成する条件を検討した.

図 2 (a) と図 2 (b) はSBA-15メソポーラス シリカ薄膜について,引き上げ方向と垂直 な断面のSEMとTEMの画像をそれぞれ示して いる.画像より薄膜が2D-hexagonal構造の 細孔を持っていることがわかる.図2(c) と図 2 (d) はイオン電流を計測する装置の 断面図と上面である.また,図2(e) はPDMS のカバーを取り付ける前のマイクロチップ の説明図である.SBA-15は薄膜上面方向に 細孔口がないため,薄膜断面方向にある細 孔口と溶液溜めが繋がるように加工する必 要がある.



図 2 SBA-15薄膜の(a) FE-SEM画像(断面 図)と(b) TEM画像(断面図).スケールは 50 nmである.(c) イオン電流計測用マイク ロチップの概略図,(d)その光学顕微鏡画像, および(e)PDMSのカバーを取り付ける前の マイクロチップの説明図.

(2) イオン移動現象の実験計測(実験計測)

濃度の異なる6つのKCI水溶液をメソポー ラスシリカ細孔と溶液溜めに満たし,DC電 場を与えることにより流れるイオン電流を 測定した.図3は測定されたⅠ-Ⅴ曲線を示す. SBA-16の場合,測定されたI-V曲線は10⁻⁵ 10⁻⁴, 10⁻³ Mの低濃度において非線形性を示 した.SBA-16はインクボトル型の細孔構造 を持ち,直径9.5 nmの球状の空洞が長さ2.0 nm, 直径2.3 nmのシリンダー型の細孔によ って繋がっている.300 Kにおける溶液のデ バイ長さ ₀は10⁻⁵, 10⁻⁴, 10⁻³, 10⁻², 10⁻¹, 1 Mの各濃度において97, 30.4, 9.7, 3.04, 0.97,0.304 nmである.したがって,濃度 が10⁻⁵, 10⁻⁴, 10⁻³ Mの時, 」は球状の直径 より大きくなり,細孔内部の水溶液はユニ ポーラな水溶液(壁面の電荷と反対符号の イオンのみが存在する水溶液)となる.こ のような濃度範囲で1-V曲線は非線形性を 示した.SBA-15は直径約5 nmの均一なシリ ンダー型の細孔を持つ.濃度が10⁻⁵,10⁻⁴, 10⁻³ Mの時,細孔内部の水溶液はユニポーラ な水溶液になるが,I-V曲線は線形であった. 一方,濃度が10⁻²,10⁻¹,1Mの時はSBA-15,

SBA-16ともI-V曲線は線形であった.



図 3 測定された電流-電圧曲線. (a)と (b) はSBA-16,(c)と(d)はSBA-15に6種類の 濃度の異なるKCI水溶液(10⁻⁵,10⁻⁴,10⁻³, 10⁻²,10⁻¹,1 M)を満たした.



図 4 コンダクタンスとイオン濃度の関係(*G-n* 曲線)(a) KCI 水溶液と(b)HCI 水溶液.

また,SBA-16 について,KCI 水溶液とHCI 水 溶液を満たした場合のI-V曲線のコンダクタ ンスと濃度の関係を図4に示す.いずれも低 濃度領域においてI-V曲線が非線形になるこ とにより,コンダクタンスが非常に小さくな る様子が捉えられている.しかし,KtとHの 易動度や表面電荷に与える影響は同じでは ない.その結果コンダクタンスが急激に低下 する濃度が異なると考えらえる.(計算結果 については後述する.)

(3) ナノ細孔内のイオンの分布,イオンの 移動現象の解析(理論解析)

先の実験で得られた I-V 曲線の非線形性を 明らかにするために数値シミュレーション を行った.図5(a)は計算モデルを示してい る.SBA-16の球状の空洞は bcc 結晶構造の原 子の位置にあるが,[111]方向を z 軸方向と 定めた.図5(b)は細孔壁に一様な表面電荷 を仮定して細孔内部の電位分布(x-z平面) を解いた計算の計算結果を示している.中央 のシリンダー周りに電位障壁ができること がわかった.さらに,定常状態におけるイオ ン電流の解析を,Poisson-Nernst-Plank式 にパラメータ C_1 ($0 < C_1 < 1$) と C_2 ($0 < C_2 < 1$)を新 たに導入した,以下の修正された Poisson-Nernst-Plank 式を用いて行った.

$$\frac{l^2 V}{dz^2} = -\frac{1}{\varepsilon_0 \varepsilon} \left(n_a z_a e + \frac{\rho_e}{C_1} \right)$$
(1)

$$\frac{dJ_{a}}{dz} = 0 \tag{2}$$

à

ここで, *J*aはイオン a の電流密度であり,次 式で与えられる.

$$J_{a} = -z_{a}eD_{a}\left[C_{2}\left(\frac{dn_{a}}{dz}\right) + \frac{z_{a}n_{a}e}{kT}\left(\frac{dV}{dz}\right)\right]$$
(3)

 D_a , n_a , z_a はそれぞれ, イオン a の拡散係数, モル濃度, 価数である. *e* は電気素量, *k* は Boltzmann 定数, *T*は絶対温度, *V*は電圧, 。 は真空の誘電率, は比誘電率である. パラ メータ C_1 (0< C_1 <1)と C_2 (0< C_2 <1)は数 nm の 空間における分子の離散性を表すために導 入した. C_1 は表面電荷の周りの誘電率を抑え, C_2 は濃度勾配によるイオン拡散を抑える効果 を表す. 図 5 (c)と図 5 (d)はパラメータ C_1 , C_2 を変化させたときの *J*-*V*曲線の変化の様子 を示している. $C_1 と C_2$ の値が1のときは線形 であるが, $C_1 と C_2$ の値が小さくなるにつれて 非線形になる様子が捉えられている.



図5(a) モデル細孔のモデルと(b) モデル 細孔内部の電位分布の計算結果.K⁺イオンの 電流密度と電極間電位差の関係(J-V曲線) について(c) パラメータ C_2 の効果と(d) パラ メータ C_1 の効果(雑誌論文 参照).

最後に,計算結果と実験結果を比較検討した. 図6はKCI水溶液の濃度とI-V曲線のコンダ クタンスの関係を示す.10⁻⁴と10⁻³Mのとき, コンダクタンスの実験値は計算値よりかな り小さく,細孔内部に存在する電位障壁によ り,イオン電流が抑制されていると解釈でき る.



図6 実験結果と計算結果の比較(コンダクタンスとイオン濃度(G-n曲線)

メソポーラスシリカ SBA-15 と SBA-16 薄膜 の合成,構造評価,およびその細孔内部を流 れるイオン電流の測定,理論解析を行った. SBA-16 薄膜はインクボトル型の細孔構造を持 ち,水溶液を満たすと細孔の狭い部分に電位 障壁ができる.細孔内部に満たされる水溶液 の濃度が十分に低い時(ユニポーラな水溶液 が満たされている時),電位障壁により /-//曲 線が非線形性を示すが,水溶液の濃度が高く なると線形になる.一方,均一なシリンダー 型の細孔を持つ SBA-15 薄膜においては , *I-V* 曲線は常に線形になる .

5.主な発表論文等

(研究代表者,研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計3件)

Junho Hwang and Hirofumi Daiguji, Ion transport in sub-10 nm Nanofluidic channels -Svnthesis. measurement and modeling, Israel Journal of Chemistry, 查読有,54,2014. Junho Hwang and Hirofumi Daiguji, Proton transport in mesoporous silica thin films SBA-16 with three dimensional cubic structures. Langmuir. 查読有, 29. 2013. 2406-2411. Hirofumi Daiguji, Junho Hwang, Asuka Takahashi, Sho Kataoka and Akira Endo, Ion transport in mesoporous silica SBA-16 thin films with 3D cubic structures, Langmuir, 査読有, 28, 2012, 2671-3677.

〔学会発表〕(計3件)

Junho Hwang and <u>Hirofumi Daiguji</u>, Ion and proton transport in mesoporous silica SBA-16 thin films with three dimensional cubic structures, ASME 11th International Conference on Nanochannels, Microchannels and Minichannels (ICNMM2013), 6/19/2013, Sapporo, Japan.

<u>Hirofumi Daiguji</u>, Transport and adsorption phenomena in mesoporous silica, ASME 10th International Conference on Nanochannels, Microchannels and Minichannels (ICNMM2013), 7/10/2012, Rio Grande, Puerto Rico.

Junho Hwang and <u>Hirofumi Daiguji</u>, Ion transport in mesoporous silica SBA-16 thin films with 3D cubic structures, 7th US-Japan Joint Seminar on Nanoscale Transport Phenomena -Science and Engineering, 12/12/2011, Shima, Japan.

6.研究組織

(1)研究代表者
大宮司 啓文(DAIGUJI HIROFUMI)
東京大学・大学院工学系研究科・教授
研究者番号:10302754

(2)研究協力者

遠藤 明(ENDO AKIRA)
産業技術総合研究所・環境化学技術研究部
門 ・グループ長